

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/136(11)
(43)2002 - 0057272
2002 07 11(21) 10 - 2000 - 0087572
(22) 2000 12 30

(71) 136 - 1

(72) 6 604 - 802
103 - 1204
708
136 - 1

(74) :

(54)

,
 .
 ,
 ; 1 가 ; 2 가
 ,
 2 1
 .
 ,
 .
 가

2b

1a, 1b

2a

2b

*

*

2a, 2c: / , 2b:

4: 1 , 4': ,

6: , 8: 2 ,

10: .

(LCD; Liquid Crystal Display)

PC , (CRT)

가 가

(ITO, IXO) (AL BASED ME

TAL) 가 가

가 (AL BASED METAL) (M

o, Cr, Ti, Ta)

가 가 .

, , 가 .

(Mo, Cr, Ti, Ta)

, 가 가 (가)

, 1a 1b (2b) , (10) (8) (2c) 가 .

, .

, ; 2 가 ; 1

, 2 1

50 1000

(New Gate Metal;) 가
18.1" FFS 2

, ()

, 2a 2b 1 (4') 가 , 2 (8) (4') (2) (2)가 .
(: 4') (10)

, 1 (4') (2) .

FFS 1 (4) (2) 1
(4')

, FFS (CAP) 2 (8)
(2b) (2) 1 (4') 2 (8)
(2) (, ESD) (2) .

, 가 .

, 1 (4')가 (2)
, 1 (4') (2) (2b)
1 (4') (attack) , 1 (4') ITO IXO .

, FFS 1 (4') (2)
(2b) (2a, 2c) , FFS (10)
(2c) 가 (2a, 2c) (6) 가
(2c) 2 (8) . , 50
1000 .

, (2) 3 (/ / ; 4') .

(4') (/ 2 (8) 1 (4') (2)
(10) (10) { (10) (2) (6) 1 (2c)
} (10) 가 .

, 1 (4) 2 (8) (2b)
(2b) (2a, 2c) BI 가 .

, 2 (8) (2b) 가 가 .

가 (4'; 1) ,

BI , 1 가

, (10) (2c) 2 (8)

, (4') (2) 1 (4') ,
 가 , 1 가 .
 FFS BI 가 BI 가 .
 , 가 .

,
 .
 가 .

(57)

1.

,
 ;
 1 가 ;

2 가 .

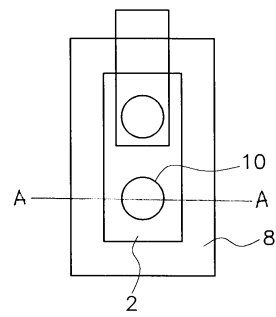
2.

1 , 1
 2 .

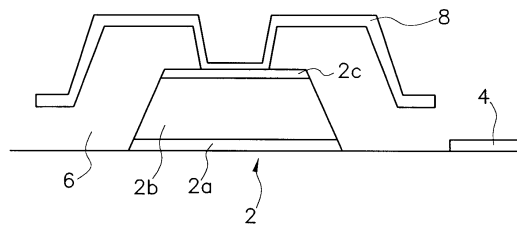
3.

1 , 50 1000
 .

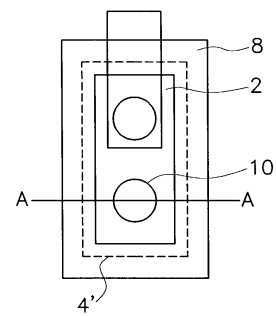
1a



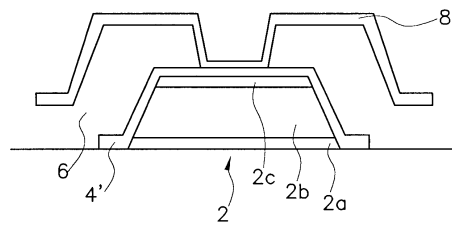
1b



2a



2b



专利名称(译)	液晶显示面板具有改善的选择性和接触性能		
公开(公告)号	KR1020020057272A	公开(公告)日	2002-07-11
申请号	KR1020000087572	申请日	2000-12-30
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	KIM HYUNJIN 김현진 LEE HONYEON 이호년 RIM SEUNGMOO 임승무 CHOI DAELIM 최대림		
发明人	김현진 이호년 임승무 최대림		
IPC分类号	G02F1/136		
其他公开文献	KR100671514B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种道路和接触性得到改善的液晶显示面板，选择，选择性和通过使得能够防止铝基底金属的直接接触，并且所述像素电极，无论程度的接触性过蚀刻通过干蚀刻在所述本发明的目的是提供一种选择性和接触特性得到改善的液晶显示板。一种铝基底金属，具有形成在玻璃基板的顶表面上的上缓冲层和下缓冲层，该缓冲层由栅极层构成；第一像素层沉积在栅极层的顶表面上；其中，形成在所述栅极层的顶部沉积在其上表面上的第二像素层，并且所述第一像素层是直接通孔干蚀刻金属栅极层的铝基材和所述第二像素层的上表面上从而阻止了接触。根据本发明，无论通孔干蚀刻中的过蚀刻程度如何，都可以防止铝基底金属和像素电极之间的直接接触。另一个效果是改善了蚀刻通孔的选择。湿法蚀刻，以及干式蚀刻的情况下，绝缘层的选择也必须改善必须更厚由于问题也有缓冲层是在一个简单的困难栅极轮廓控制按照控制厚最小化所述缓冲层的厚度的缓冲层的约束是的。 - 1 - 图2b

